

Обозначение	Характеристика процесса	Применение, элементная база PDF
<input type="checkbox"/> <u>БикДМОП 48 В с изоляцией р-п переходом 1 ПКК 1 металл</u>	Кол-во фотолитографий, шт. 16 Средняя проектная норма, мкм 3,0 Подложка: 460КДБ12 [100] Скрытые слои: 20КЭС6/250КДБ2.0 Эпитаксиальный слой 12КЭФ1.5 Изоляция: р-п переход Глубина Р-кармана, мкм 5.0 Подзатворный SiO ₂ , Å 750 Межслойный диэлектрик - СТ ФСС, мкм 0,8	ИС исполнительных устройств силовой электроники Вертикальный NPN: h21э=25-90 Uсе=20-70 В Горизонтальный PNP: h21э=2,2-30 Uсе=25-60 В NДМОП: Vtn=1.8-2.6В, Usd=60-100 В PМОП низковольтный: Vtp=0.8-1.4 В, Usd =20-35 В PМОП высоковольтный: Vtp=1.2-2.2 В, Usd =30-80 В NМОП транзистор: Vtn=1.1-1.7 В, Usd =15-25 В ИМС управления импульсным источником питания Низковольтный NPN: h21э не менее 50, Uсе не менее 30 В Горизонтальный PNP: h21э=2,2-30 Uсе=25-60 В NДМОП: Vtn=1.2-3.0 В, Usd ³ 30 В PМОП низковольтный: Vtp=0.8-2.0 В, Usd ³ 18 В PМОП высоковольтный: Vtp=0.8-2.0 В, Usd ³ 22 В NМОП низковольтный: Vtn=0.8-2.0 В, Usd ³ 18 В NМОП высоковольтный: Vtn=0.8-2.0 В, Usd ³ 600 В
<input type="checkbox"/> <u>БикДМОП 600 В с изоляцией р-п переходом 1 ПКК 1 металл</u>	Кол-во фотолитографий, шт. 15 Средняя проектная норма, мкм 3,0 Подложка: 460КДБ60 [100] Изоляция: р-п переход Глубина базы NДМОП, мкм 2.5 Подзатворный SiO ₂ , Å 750 Межслойный диэлектрик - СТ ФСС, мкм 0,8	Аналоговые ИС малой и средней степени интеграции с Ep до 90 В Вертикальный NPN: Vn=50 Uсе=20 В Горизонтальный PNP: Vp=25 Uсе=20 В LNДМОП: Vtn=2.0 В, Usd >90 В LPДМОП: Vtp=-1.4 В, Usd >90 В NМОП: Vtn= 1.2 В, Usd >18 В PМОП: Vtp= 1.5 В, Usd >18 В VNДМОП: Vtn= 2.0 В, Usd >70 В Резисторы в слое: База NДМОП, P-сток, ПКК. Емкости: ПКК-Si (SiO ₂ 750 Å) ПКК-Al (SiO ₂ 8000 Å)
<input type="checkbox"/> <u>90 В, с изоляцией р-п переходом 1 ПКК 1 металл, NМОП/PМОП низковольтные транзисторы, NДМОП/PДМОП высоковольтные горизонтальные транзисторы, мощный вертикальный NДМОП транзистор, биполярные вертикальные NPN и горизонтальные PNP транзисторы</u>	Кол-во фотолитографий, шт. 19 Средняя проектная норма, мкм 4,0 Подложка: 460КДБ12 [100] Скрытые слои: 20КЭС6/250КДБ2.0 Эпитаксиальный слой 10КЭФ1.5 Изоляция: р-п переход Глубина Р-кармана, мкм 6.5 Глубина базы NДМОП, мкм 2.5 Подзатворный SiO ₂ , Å 750 Глубина р-базы NPN, мкм 2.5 Глубина N+эмиттера, мкм 0,5 Межслойный диэлектрик - БФСС, мкм 0,8 Длина канала по затвору: N/PМОП, мкм ø 4 шаг ПКК, мкм 7 контакты, мкм 2 шаг по металлу, мкм 8	Аналоговые ИС малой и средней степени интеграции с Ep до 90 В Вертикальный NPN: Vn=50 Uсе=20 В Горизонтальный PNP: Vp=25 Uсе=20 В LNДМОП: Vtn=2.0 В, Usd >90 В LPДМОП: Vtp=-1.4 В, Usd >90 В NМОП: Vtn= 1.2 В, Usd >18 В PМОП: Vtp= 1.5 В, Usd >18 В VNДМОП: Vtn= 2.0 В, Usd >70 В Резисторы в слое: База NДМОП, P-сток, ПКК. Емкости: ПКК-Si (SiO ₂ 750 Å) ПКК-Al (SiO ₂ 8000 Å)
<input type="checkbox"/> <u>БикДМОП, с изоляцией LOCOS 1 ПКК 1 металл, NМОП/PМОП транзисторы</u>	Кол-во фотолитографий, шт. 15 Средняя проектная норма, мкм 2,8 Подложка: КДБ 80	Низковольтные транзисторы NМОП: Vtn= 1.8 В, Usd >16 В PМОП: Vtp= 1.5 В, Usd >16 В

Изоляция:	LOCOS	NPN: h21э =
Глубина P-кармана, мкм		100-300
6,5		Резисторы в
Глубина N-кармана, мкм		слое:
4,5		ПКК 1 = 20-30
Глубина базы NДМОП,		Ом/кв.
мкм 2,4		
Подзатворный SiO2,		Высоковольтные
Å 600		транзисторы
Межслойный диэлектрик -		NДМОП: Vtn=
СТФСС, мкм		1.0-1.8 В ,
0,6		Usd>=500 В
Длина канала: NMOS/PMOS,		РДМОП: Vtr=
мкм 2,0		0.7-2.0 В , Usd
контакты, мкм		>=700 В
2.0x2.0		
шаг металл 1,		
мкм 8		
шаг металл 2, мкм		
10		

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ



© 1998-2020,
Холдинг "ИНТЕГРАЛ"

Авторские права



ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Разработка
сайта: